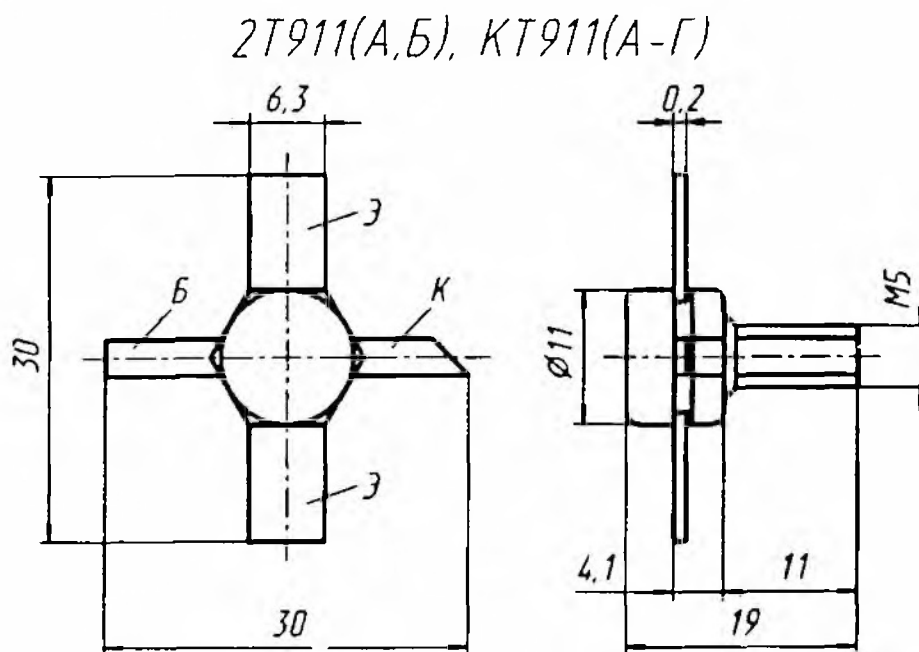


2Т911А, 2Т911Б, КТ911А, КТ911Б, КТ911В, КТ911Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $n-p-n$ генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности, умножителях частоты и автогенераторах на частотах более 400 МГц при напряжении питания 28 В. Выпускаются в металлопластмассовом корпусе с полосковыми выводами и монтажным винтом. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 6 г.



Электрические параметры

Выходная мощность при $U_{кз} = 28$ В,
 $T_k \leq +40$ °С:

на частоте $f = 1,8$ ГГц, не менее:

КТ911А	1 Вт
2Т911А, КТ911В	0,8 Вт

на частоте $f = 1$ ГГц, не менее:

КТ911Б.....	1 Вт
2Т911Б, КТ911Г	0,8 Вт

Коэффициент усиления по мощности
 при $U_{кз} = 28$ В, $T_k \leq +40$ °С, не менее:

на частоте $f = 1,8$ ГГц:

2Т911А, КТ911В при $P_{вых} = 0,8$ Вт.....	2
КТ911А при $P_{вых} = 1$ Вт.....	2,5

на частоте $f = 1$ ГГц:

2Т911Б, КТ911Г при $P_{вых} = 0,8$ Вт	2
КТ911Б $P_{вых} = 1$ Вт	2,5

Коэффициент полезного действия коллекто-

ра на частоте $f = 1...1,8$ ГГц при $U_{кз} = 28$ В, $P_{вых} = 0,8$ Вт, не менее	23%
типичное значение	40*%
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 5$ В, $I_3 = 200$ мА, не менее	15*
типичное значение	40*
Модуль коэффициента передачи тока на вы- сокой частоте при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 100$ мА, $f = 300$ МГц, не менее:	
2Т911А	3,34
2Т911Б	2,8
КТ911А, КТ911В	2,5
КТ911Б, КТ911Г	2
Критический ток на частоте $f = 300$ МГц при $U_{кз} = 10$ В:	
2Т911А, КТ911А, не менее	170 мА
типичное значение	220* мА
2Т911Б, КТ911Б, не менее	150 мА
типичное значение	220* мА
КТ911В, не менее	160 мА
КТ911Г, не менее	140 мА
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 30$ мА, $f = 5$ МГц, не более:	
2Т911А, 2Т911Б, КТ911А, КТ911Б	25 пс
КТ911В	50 пс
КТ911Г	100 пс
Емкость коллекторного перехода на частоте $f = 5$ МГц при $U_{кб} = 28$ В, не более	10 пФ
типичное значение	4* пФ
Емкость эмиттерного перехода на частоте $f = 5$ МГц при $U_{эб} = 0$, типичное значение	18* пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кб, макс}$, не более:	
$T = +25$ °С:	
2Т911А, 2Т911Б	3 мА
КТ911А, КТ911Б, КТ911В, КТ911Г	5 мА
$T = +125$ °С для 2Т911А, 2Т911Б	10 мА
$T = +85$ °С для КТ911А, КТ911Б, КТ911В, КТ911Г	10 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 3$ В, не более:	
2Т911А, 2Т911Б	1 мА
КТ911А, КТ911Б, КТ911В, КТ911Г	2 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:	
2Т911А, 2Т911Б, КТ911А, КТ911Б	55 В
КТ911В, КТ911Г	40 В
Постоянное напряжение эмиттер—коллектор при $R_{эб} \leq 100$ Ом:	
2Т911А, 2Т911Б, КТ911А, КТ911Б	40 В
КТ911В, КТ911Г	30 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	3 В
Постоянный ток коллектора	400 мА
Средняя рассеиваемая мощность ¹ в динамическом режиме:	
при $T_k \leq +50$ °С для 2Т911А, 2Т911Б	3 Вт
при $T_k \leq +25$ °С для КТ911А, КТ911Б, КТ911В, КТ911Г	3 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	33 °С/Вт
Температура <i>p-n</i> перехода:	
2Т911А, 2Т911Б	+150 °С
КТ911А, КТ911Б, КТ911В, КТ911Г	+120 °С
Температура корпуса:	
2Т911А, 2Т911Б	+125 °С
КТ911А, КТ911Б, КТ911В, КТ911Г	+85 °С
Температура окружающей среды:	
2Т911А, 2Т911Б	−60... $T_k = +125$ °С
КТ911А, КТ911Б, КТ911В, КТ911Г	−40... $T_k = +85$ °С

При установке транзистора на теплоотвод запрещается прикладывать скручивающие усилия к пластмассовой части корпуса. Шероховатость контактной поверхности теплоотвода должна быть не менее 2,5. Неплоскостность контактной поверхности теплоотвода должна быть не более 0,03 мм.

Пайка выводов транзистора допускается не ближе 2 мм от корпуса по методике, не приводящей к нарушению конструкции транзистора. Пайку проводить паяльником при температуре не более +260 °С в течение не более 6 с. Необходимо осуществлять теплоотвод между корпусом и местом пайки.